PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-015947

(43) Date of publication of application: 19.01.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/82

H01L 27/04

(21)Application number : **62-171980**

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

09.07.1987

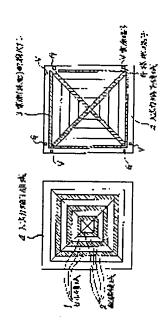
(72)Inventor: OUCHI YASUNORI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To increase the cell density by annularly placing cell regions and wiring regions in the four triangular sections obtained by partitioning a quadrangular chip with the diagonal lines, along and in parallel with the perimetrical sides, thereby narrowing the width of the wiring regions.

CONSTITUTION: The device is provided with a construction in which a quadrangular chip is partitioned into four with the diagonal lins and internal cell regions I and wiring regions 2 are placed in the four respective triangular sections along and in parallel with the perimetrical sides, that is, a structure in which cell regions the lengths of which sequentially become shorter from the outermost perimetry to the center are annularly arranged in a quadrangle along the perimetrical sides. The interconnections between the individual cells in the cell regions are uniformized since the wiring regions 2 are also annular as with the cell regions 1, and it is possible to narrow the width of the wiring regions 2. Then, a power supply and grounding wiring pattern 3 is connected to a power supply terminal V and a ground terminal G of an input/output



terminal region 4 and provided along the perimeter of the chip and the diagonal lines. Accordingly, the wiring is shortened, the voltage drop decreases, and the operation of the cell circuit is assured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

CLIPPEDIMAGE= JP401015947A

PAT-NO: JP401015947A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01015947 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OUCHI, YASUNORI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62171980

APPL-DATE: July 9, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/82;H01L027/04

US-CL-CURRENT: 257/210

ABSTRACT:

PURPOSE: To increase the cell density by annularly placing cell regions and wiring regions in the four triangular sections obtained by partitioning a quadrangular chip with the diagonal lines, along and in parallel with the perimetrical sides, thereby narrowing the width of the wiring regions.

CONSTITUTION: The device is provided with a construction in which a quadrangular chip is <u>partitioned</u> into four with the diagonal lins and internal cell regions 1 and wiring regions 2 are placed in the four respective triangular sections along and in parallel with the perimetrical sides, that is, a structure in which cell regions the lengths of which

09/05/2002, EAST Version: 1.03.0002

sequentially become shorter from the outermost perimetry to the center are annularly arranged in a quadrangle along the perimetrical sides. interconnections between the individual cells in the cell regions are uniformized since the wiring regions 2 are also annular as with the cell regions 1, and it is possible to narrow the width of the wiring regions 2. Then, a power supply and grounding wiring pattern 3 is connected to a power supply terminal V and a ground terminal G of an input/output terminal region 4 and provided along the perimeter of the chip and the diagonal lines. Accordingly, the wiring is shortened, the voltage drop decreases, and the operation of the cell circuit is assured.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭64-15947

@Int_Cl_1

識別記号

厅内整理番号

◎公開 昭和64年(1989)1月19日

H 01 L 21/82 27/04

7925-5F A-7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

会発明の名称 半導体装置

②特 頤 昭62-171980

❷出 顋 昭62(1987)7月9日

总 明 者 大 内 康 憲 意出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気抹式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

念代 理 人 一弁理士 栗田 春雄

明 細 資

発明の名称
 半導体装置

2 特許請求の範囲

- (1) 多数のトランジスタを有するセル領域と、 これらに配額を行う配線領域とを、上下辺に沿って交互に平行に配置し、 顕客の要求により前記配線領域の配線パターンのみを設計して形成ける四角形のチップからなるゲートアレイあるいはスタンダードアレイ設計方式の半導体装置にかいて、 前配四角形のチップをその対角線に沿って、前配四角形のチップをその対角線に沿って4つに区分し、 これら4つの三角形の各部分にチップの周囲辺に平行に前記セル領域をよい配置することを特徴とする半導体装置。
- (2) 世級配銀および接地配線を対角級に沿って設 けた特許請求の範囲第(1)項記載の半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はゲートアレイやスタンダードセルの設計方式を用いて、肌客の住文に応じて論類回路を任意に形成するLSIチップからたる半導体装置に関し、特にゲートアレイやスタンダードセルのセル配置かよび電販配線に関するものである。

従来の技術

近年、各種の電子装置の多級化に対して積々の 論理回路を有する半導体装置が用いられ、少量多 品種化の傾向にある。とれに対処するために、ト ランジスタを有する基本構成(セル)を規則的に 配列した半導体装板上に、顕客の要求にあった院 級パターンを設計形成して、半導体装置を形成す ることが広く行われている。

従来、この種の半導体装置の一例は第4図に示すように、テップの上下辺に沿ってゲートアレイヤスタンダードセルが配列されるセル領域1と、 配級領域2とが交互に平行に配置され、周囲に入山力路子領域4を有するものであった。そしてセ ル領域1の同一の列間および異った列間にある各々のセル相互間の接続配設は、主に配線領域2内で行われ、かつとの配線領域2においては、一般にセル領域1に平行するX軸とこれに直交するY軸との2つの方向の配線パターンを別々の2層に設け、折曲げ部にスルーホールを用いて配線するものであった。

したがって配線領域2の配線パターンの分布は、 第5図に示すように両側部6で少なく中央部5に 集中する傾向があり、配線領域2の幅は中央部5 の配線量に合わせて比較的に広くとる必要があり、 両側部6では配線密度が少なく有効に使用されず、 そのためセル領域が成少するという欠点があった。

また、チップ周辺にある入出力端子領域4上の 電板端子かよび接地端子からチップ内のセル領域 1に電限電圧を供給するための電磁配線かよび接 地配線も、同じくセル領域1に沿って配優される ため、チップの中央部までの配線パターンの距離 が長くなり、配線に生ずる電圧の降下によりセル 回路の動作マージンを低下させる原因となってい

短くなる四角の現状に配似されているため、セル 領域間の配線領域における配線分布は、中心に対 して対称すなわち一様になり平均化される。

また電源配線パターンを対角線に沿って通すと とにより、配線距離が短縮してUIEの降下が減少 し、回路の動作が安定する。

尖施例

次に本発明の実施例について図面を参照して説 努する。

本発明の一契施例を平面図で示す第1図を診照すると、本発明の半導体換配は、四角形のチップを対角級で4つに区分し、この区分された4つの各三角形部分に、内部セル領域1と配数領域2とを周囲辺に沿って平行に配置した構成、すなわちテップの機外风から中央に向って及さが瓜に短くなるセル領域を周囲辺に沿って四角に現状に並べた構造になっている。また外周には入出力端子領域4を有している。

次に本災施例の動作について第1回を用いて説 明する。 t.

発明が解決しよりとする問題点

本発明の目的は、上記の欠点、すなわら平行に配置されるセル領域間の配線領域の概を広くとらなければならず、セル領域が減少するという問題点、また電原端子および接地端子からセル領域をの電源供給のための配線が投くなり、電圧の降下が起き易いという問題点を解決した半浮体装置を提供するととにある。

問題点を解決するための手段

本発明は上述の間数点を解決するために、四角形のチップを対角線で4つに区分し、 この区分された4つの三角形部分に、内部セル領域と配線領域とを、周囲辺に沿って平行に配配し金体として現状とした構成を採用するものであり、特にこのチップ上の対角線に沿って電源配級を通す構成を採用するものである。

作用

本発明は上述のように構成したので、セル領域 がチップの最外周から中央に向って、長さが順に

セル領域1内にある個別のセル間の相互配線は、 配級領域2もセル領域1と同様に環状になってい るため、配線の均一化が図られ、配線領域2の塩 を従来よりも残めることが可能になる。

更に、第3四に示すように、チップの上下辺に 和った三角形部分A およびじと左右辺に沿った三 角形部分B および D において、 直交する X 他およ び Y 軸の 2 層配級の層をセル領域の配置 (及さの) 方向 F に合わせて上下層を逆向きに定めることに より、 阿一配線 M を用いてチップ内を項状に一局 することが可能になり、 X 軸。 Y 軸折血げのため のスルーホールの数を少なくすることが可能にな る。

次に第2図は第1図のチップに設けられる電源かよび接地の配線の構成を示してかり、電源かよび接地配線バターン3は入山力端子領域4の電源 端子 V かよび接地端子 G に接続されて、チップの周囲かよび対角線に沿って設けられている。したかって、この電源(接地)配線バターン3からせん で域の各七ル迄の配線が組織化され、電圧降下

が似少し、セル回路の動作を確災にすることがで きる。

なか、との対角線上の北京および接地配線バターン3は、一般の2階の配線層の上の第3階に並べて設けることもできるし、前述の各三角形部分の配線のX4曲、Y4軸の逆転の場合に、配線のない対角線面に設けるなど任意の方法が決適される。

ただし中心の対角級配線の交点については、電 源、扱地いずれかをスルーホールを用いて他の面 で接続するか、飛越し配線を行わせるなどによっ て実施される。

発明の効果

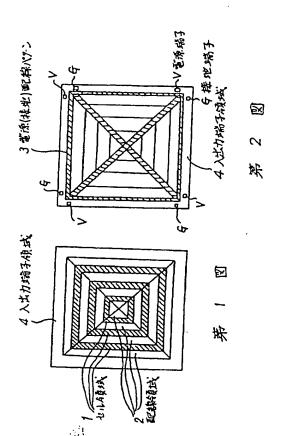
以上に説明したように、本系明によれば、四角形のチャブを対角線で区外した4つの三角形部分に、周囲辺に沿って平行にせん領域および配融領域を現状に配置することにより、配線領域の幅を狭くでき、せん密度の増加が図れるという効果がある。また電弧(接地)配線パメーンを対角線に沿って設けることにより、地域および接地の配線長をより短くし、せん回路の動作を確実にすると

いう効果がある。 型に配線領域のX軸とY軸とを 三角形部分で交互に逆に定めることにより配錐の ためのスルーホール数を少なくし、信頼性を向上 できるという効果がある。

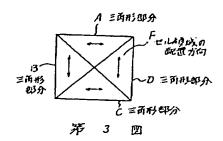
4. 図面の簡単な説明

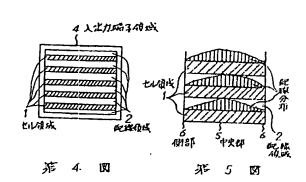
第1図は本条明の一尖施例の平面図、第2図は本発明の構成における単純(接地)配線を示す図、 第3図は本発明のセル領域の配置方向を示す図、 第4図は従来のセル領域と配線領域とを示す図、 第5図は第4図の場合の配線分布を示す図である。

1……七~領域、2……配線領域、3…… 電板 (接地)配解バターン、4……人出力附子領域、 A.B,C.D……三角形部分、F……七~領域の 配置方向、G……接地端子、V……電源端子。



...





		·